



2026年1月16日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 オ キ サ イ ド

代 表 者 名 代表取締役社長(COO 兼 CFO) 山 本 正 幸

(コード番号: 6521 東証グロース)

問 合 せ 先 執行役員(CSO)企画本部長 竹 内 健 吾

(TEL. 0551-26-0022)

2026年2月期 第3四半期 決算説明会の質疑応答（要旨）について

当社は、昨日決算説明会（アナリスト・機関投資家向け）を開催いたしました。ご出席の皆様からいただいた主なご質問を以下にまとめております。なお、理解促進のため、一部加筆修正を行い要旨として記載をしております。

Q. 今回の決算を見ると売上トップラインが前期比で11%増えており、オキサイド単体では黒字なのは安心しました。しかしイスラエルの子会社である Raicol 社の赤字が想定以上に長引いており、連結業績の重荷になっているのは心配です。第2四半期の決算発表時の説明では、下半期は収益が均衡すると聞いておりましたが、状況が悪化したのでしょうか。Raicol 社の状況や今後の見通しについて教えてください。

A. イスラエル紛争の影響による一部地域での不買運動の継続やインフレによるコスト上昇など、外部環境の改善は残念ながら依然として見られません。

第2四半期比で第3四半期は売上高自体は増加したものの、インフレや原材料高騰の影響が想像以上に大きく、収益構造が悪化した結果、引き続き営業赤字となりました。

このように Raicol 社の業績については将来の見通しを立てることが非常に困難な状況です。

この状況を踏まえて、オキサイド単体で様々な営業利益創出案件に取り組むことでリカバリーし、通期業績予想に変更はございません。

ただし、Raicol 社業績においては特に収益性が課題であります。オキサイドグループ企業価値の最大化は経営課題として認識をしており、現在あらゆる選択肢を検討しております。

01.連結業績

通期連結営業損益の着地見込み

OXIDE

■ 第3四半期累計連結営業損益は、OXIDE単体およびOPCでは概ね予想通りに推移したものの、Raicolで3億2,900万円予想を下回りました。これに対して、様々な営業利益創出案件に取り組んでおり、通期業績予想に変更はございません。

【第4四半期営業利益の予想比増加の主な要因】

- 新領域事業 約3億円:データセンター向けファラデー回転子の追加出荷、OPCでの費用圧縮
- 半導体事業 約1億円:深紫外レーザー・単結晶の出荷増と次世代レーザー開発受託

(単位:百万円)

項目	26年2月期 上半期			26年2月期 3Q			26年2月期 3Q累計			26年2月期 4Q			26年2月期 通期		
	予想	実績	予想比	予想	実績	予想比	予想	実績	予想比	予想	見込	予想比	予想	見込	予想比
連結営業損益※1	50	▲189	▲240	32	▲68	▲100	82	▲258	▲340	326	667	+340	409	409	+0
OXIDE単体	277	312	+35	93	97	+3	371	410	+38	451	800	+348	822	1,210	+387
Raicol	▲57	▲285	▲228	4	▲97	▲101	▲53	▲382	▲329	31	▲50	▲81	▲21	▲432	▲411
OPC※2	▲169	▲196	▲26	▲65	▲78	▲13	▲235	▲274	▲39	▲156	▲106	+50	▲391	▲380	10

Copyright: 2026 OXIDE Corporation. All Rights Reserved.

※1 連結と各内訳数字合計の差異は、連結調整によるものです。
 ※2 OPC:当社100%子会社で、SiC事業に取り組むオキサイドパワークリスタル社の略称です。

- Q. Raicol 社買収後、不運にも紛争期間が長期間にわたっていますが、買収時に想定していた事業上のシナジーの進捗はあるのでしょうか？
- A. 買収時に想定していたシナジーについては技術面および販売面があります。
- 技術面でのシナジーについては、紛争期間においても Raicol 社のエンジニアがオキサイドを訪問し技術的な交流を行うなどし、深紫外レーザ用結晶やファラデー回転子において成果が得られています。
- 販売面でのシナジーにおいては、展示会の共同出展を通して、特に量子分野におけるマーケティング活動が進みました。

質疑応答

Raicol社の状況について

OXIDE

- ■ イスラエル紛争の影響による一部地域での不買運動の継続やインフレによるコスト上昇など、外部環境の改善は依然として見られません。
- ■ 一方で、買収時に想定していた販売面および技術面でのシナジーについては、例えば深紫外レーザ用結晶やファラデー回転子ビジネスにおける協業において成果が得られています。
- ■ ただし、Raicol社業績においては特に収益性が課題であり、営業損失が3四半期で継続しております。
- ■ オキサイドグループ企業価値の最大化は経営課題として認識をしており、現在あらゆる選択肢を検討しております。

Q. 半導体事業では、一昨年の部材不具合問題は完全に解決し、売り上げも伸びており、今後が期待できると思います。特に、新製品の「193nm 全固体レーザ」と「266nm 高出力レーザ」は楽しみです。こちらは、競合他社の製品と比較して、技術的な優位性は具体的にどこにあるのでしょうか？ 他社には真似できない技術なのでしょうか？もう少し詳しく教えてください。

A. 新たに開発に成功した波長 193nm レーザは、平均出力 0.2W、繰り返し 50MHz を実現した全固体深紫外レーザです。このレーザはエキシマレーザに比べ高いビーム品質が実現可能であり、分解能の高いマスク検査が可能です。他社のレーザで本製品と同等の性能を実現しているものではありません。

266nm 高出力モデルでは、当社独自の高品質単結晶と波長変換技術により従来の 3W から標準 8W、最大 12W へと出力を高めました。これにより、半導体ウエハ欠陥検査の分解能とスループットの向上に寄与します。

両製品ともに、当社が長年培ってきた高品質単結晶技術と波長変換技術の蓄積により世界トップクラスの性能を達成しました。

質疑応答

半導体 | 新製品発表－競合優位性

OXIDE

- 半導体検査向けレーザの短波長化・高出力化という当社ロードマップを、独自の単結晶と波長変換技術により推進し、193nm全固体レーザと266nm高出力レーザを製品化しました。



フォトマスク
欠陥検査用

193nm全固体レーザ

フォトマスク欠陥検査、次世代ウエハ欠陥検査などの高解像度を必要とする検査装置市場に新たに参入します。

- 大型・高コスト・メンテナンス頻度が課題であったArFエキシマレーザを全固体化し、省スペース・高安定性・長寿命を実現
- 全固体化により高ビーム品質($M^2 < 1.3$)および狭線幅($< 5\mu\text{m}$)を達成し、検査の高精細化に貢献
- 市販の193nm全固体レーザとして最高水準となる高出力0.2Wと高繰り返し50MHzを同時に実現(他社性能: $< 0.01\text{W}$ 、繰り返し $< 15\text{kHz}$)



ウエハ
欠陥検査用

266nm高出力レーザ

ウエハ欠陥検査の高スループット化に貢献し、既存市場のシェア拡大を目指します。

- 従来3Wだった266nmレーザの出力を標準8W、最大12Wまで高出力化し、半導体ウエハ検査の高スループット化に貢献
- 他社出力最大3Wに対し、大幅に上回る8W出力で5,000時間超の長期安定動作を実現
- 従来機と同様の外観・サイズを維持し、既存検査装置との高い互換性を確保

Q. 韓国で開催された ICSCRM や、日本の SEMICON Japan で展示された青色の p 型 SiC ウエハが、これまでになかった SiC 基板用途として注目されたと聞いています。その用途として市場が大きいデータセンターがあるようですが、いつから量産が開始され、売上に貢献するのでしょうか？

A. p 型 SiC ウエハは、高品質ウエハが求められる直流送電 (HVDC) やデータセンター向け SST などの超高耐圧領域を主なターゲットとしております。

昨年 9 月の SiC 国際学会 (ICSCRM) および 12 月の SEMICON Japan でのサンプル展示以降、多くの顧客やパートナー企業から引き合いをいただいております。現在はサンプル評価の段階でございます。

製品出荷開始時期につきましては、用途ごとに異なる想定です。データセンター向け SST 用途では応用開発の進捗を踏まえ、2028 年ごろからの出荷開始を目指しております。一方、HVDC 用途については、より長期にわたる評価認定プロセスが想定されることから、2030 年ごろの出荷開始を一つの目安としております。

本製品は、次世代電力インフラの高度化やエネルギー効率向上に寄与する社会課題の解決に不可欠なものと考えています。

質疑応答

新領域 | SiC事業の進捗

OXIDE

- オキサイドパワークリスタル社が幹事を務めるコンソーシアムは、革新的な溶液成長法とAIデジタルツインを駆使し、6インチp型SiCウエハ試作に成功しました。※1
- 昨年12月開催SEMICON Japanでの展示以降、多くの顧客やパートナー企業から引き合いをいただいております。現在はサンプル評価の段階です。
- p型SiCウエハを用いて、直流送電(HVDC)やデータセンター向けSSTなど超高耐圧領域における社会実装を目指します。

p型SiCウエハの社会実装が期待される領域

①直流送電(HVDC)

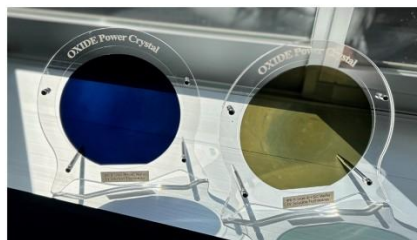
- ・ 直流送電(HVDC)は、再生可能エネルギーインフラにおいてカギとなる重要分野
- ・ Si IGBTに代わりp型SiCウエハを用いたSiC IGBTの適用が期待されている
- ・ 製品出荷(想定):2030年~

②データセンター向けSST

- ・ 生成AI普及によるデータセンター需要増加を受け、電力供給の効率化が社会課題
- ・ NVIDIA社等が主導しデータセンター向けの高電圧配電計画が進んでおり、SST(Solid State Transformer:半導体変圧器)が重要となる
- ・ このSSTにおいて、10kV~20kV耐圧のSiC IGBTの市場機会が創出される
- ・ 製品出荷(想定):2028年~

SiCウエハの色とドーパントの関係

- ・ SiCはドーパントによる光吸収特性の違いで色が変わり、n型ウエハは琥珀色、p型ウエハは青色を示す
- ・ 青色を示すp型SiCウエハ試作に成功



6インチp型ウエハ(左)6インチn型ウエハ(右)

Q. オキサイドは量子銘柄としても注目されていますが、今回、量子分野の話題の説明がありませんでした。何か進捗はありましたか？

A. 量子分野向け製品の開発は着実に進捗しております。

当社は、単結晶、デバイス、モジュール、レーザといった量子分野のサプライチェーンを支える幅広い製品群を有しております。特に量子コンピューティングに関しては、足元で中性原子方式に利用されるレーザに対する引き合いが増加しております。

単結晶、デバイスにおいては安定な引き合いを頂いており、リピート製品が増加しています。

モジュールについても、もつれ光子対光源モジュールの開発依頼が継続している状況です。

守秘義務がありますので詳細はお話しできませんが、顧客との製品開発や重要サプライヤーとの協業など、複数の案件に取り組んでおります。

質疑応答

新領域 | 量子分野の進捗

OXIDE

■ 当社は、量子分野のサプライチェーンを支える「単結晶」「モジュール」「レーザ」といった幅広い製品を提供しており、顧客との製品開発や重要サプライヤーとの協業など、複数の案件に注力しています。

- 量子コンピューティング用レーザ 中性原子方式やイオントラップ方式に利用されるレーザの引き合いが増加。
- モジュール もつれ光子対光源モジュールの開発依頼が継続。
- 単結晶・デバイス 安定した引き合いがあり、リピート製品が増加。

特に引き合いが増加			
単結晶	波長変換デバイス	量子もつれ光子対光源モジュール	量子コンピューティング用レーザ
			
川上(応用範囲が広い)	量子分野における当社の製品群		川下(特定分野で高い付加価値)

Copyright: 2026 OXIDE Corporation. All Rights Reserved.

15

- Q. 半導体事業において、第4四半期以降での出荷に取り組んでいる新製品とは具体的に何を指しているのでしょうか。この新製品による第4四半期売上への寄与はどの程度あるのでしょうか。また、新製品以外の売上寄与もあるのでしょうか。
- A. 当社が昨年12月に発表した新製品を指しており、193nm 全固体レーザーおよび266nm 高出力レーザーです。193nm は短波長領域、266nm は高出力領域と、いずれも半導体事業における当社の開発ロードマップの重要なテーマです。
一部のお客様とは新製品発表前より協議を進めており、第4四半期から段階的に売上に寄与する見込みです。
第4四半期の売上に関しては、従来レーザー製品やメンテナンス需要の増加に加えて、新製品の売上も見込んでおります。
- Q. ヘルスケア事業において、第2四半期は8億円を超える売上でしたが、第3四半期は減少しています。この実績推移の背景と、従来顧客および新規顧客の需要トレンドを教えてください。
- A. 第2四半期の売上は、前期からの期ズレ案件が一部含まれていたため、一過性の高い水準となっていました。第3四半期以降は、新規顧客向けの出荷が中心となり、継続的に売上へ寄与する見込みです。
- Q. 第4四半期において、オキサイド単体で8億円という高い営業利益を見込んでいます。この営業利益について、半導体・ヘルスケア・新領域の事業別での寄与度を教えてください。
- A. 第4四半期の営業利益額で最も大きく寄与するのは半導体事業です。
次いで、ファラデー回転子を含む新領域事業が寄与する見込みです。
また、予算対比の増加率の観点では、新領域事業の伸長が最も大きく、第4四半期の営業利益に寄与すると考えております。
- Q. 先日の SEMICON Japan で貴社の溶液法 p 型 SiC ウエハを拝見しました。同会場では、中国メーカーの溶液法 SiC p 型ウエハも展示されていました。溶液法 SiC の開発をリードしているのは、中国メーカーなのでしょうか。
- A. 昇華法 SiC ウエハにおいては、従来、米国メーカーが市場をリードしていましたが、近年は中国政府の支援を受け、中国メーカーがシェアを拡大しています。溶液法についても、中国メーカーの1社は十数年以上前に製品開発に着手し先行しています。
これに対して、当社は育成装置導入完了から約2年の短期間で p 型 SiC ウエハの育成に成功しております。この開発スピードは市場から高く評価されています。
今後は、NEDO GIF コンソーシアムで連携する溶液法の世界的な第一人者である名古屋大学・宇治原先生との共同研究を通じて、他社を上回る品質のウエハ実現を目指して開発を進めてまいります。